



# SHE124PGH / SHE124PGH-(B)

Semiconductor

High Brightness LED Lamp

## Features

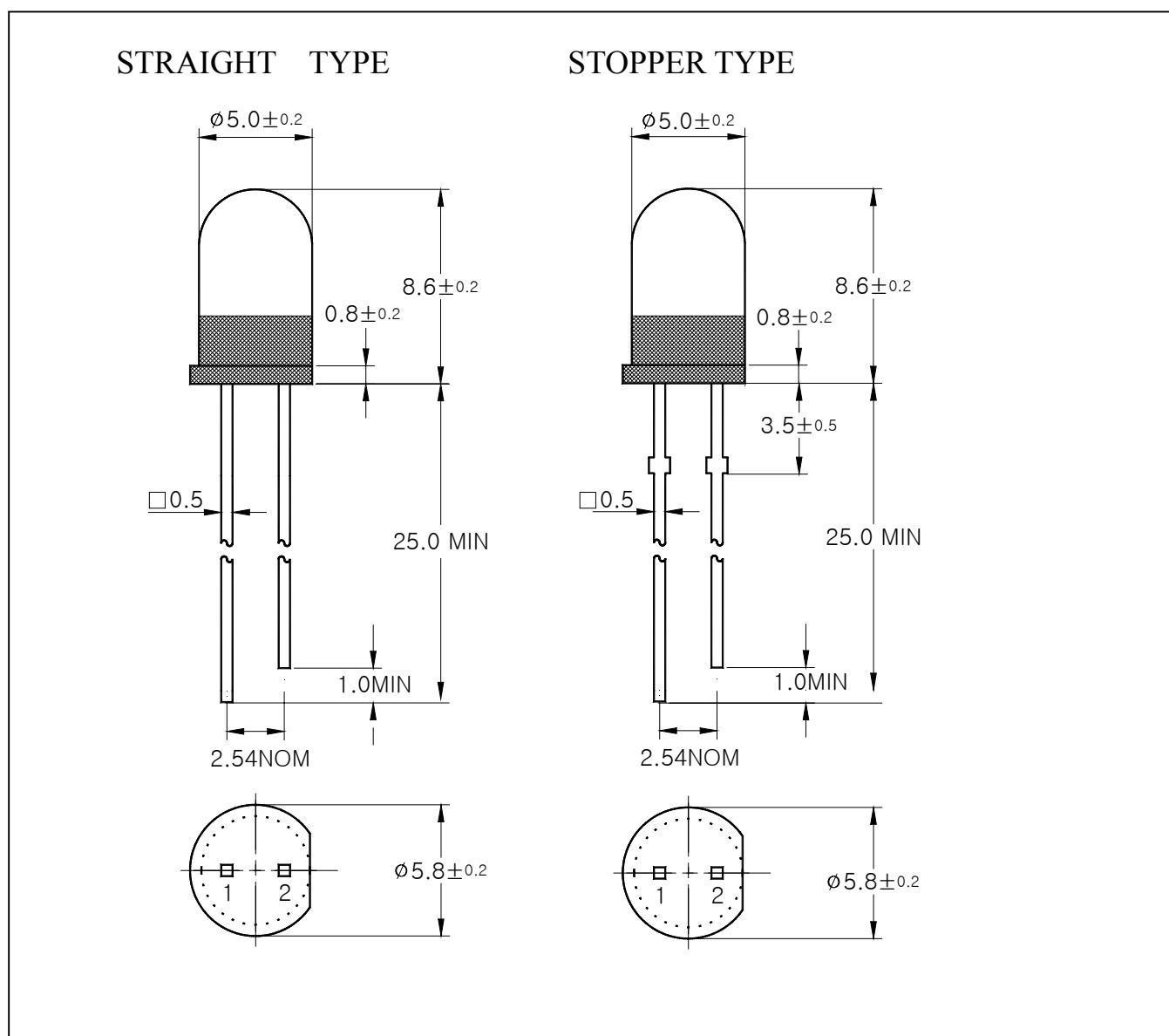
- Green Colored lens type
- $\phi 5\text{mm}(\text{T}-13/4)$  all plastic mold type
- Viewing angles :  $40^{\circ}$
- Super luminosity

## Application

- Traffic Signal
- Message Board
- Variable message signs(VMS)

## Outline Dimensions

unit : mm



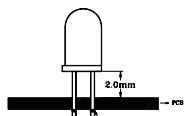
# SHE124PGH / SHE124PGH-(B)

## Absolute maximum ratings

Characteristic	Symbol	Ratings	Unit
Power Dissipation	P <sub>D</sub>	155	mW
Forward Current	I <sub>F</sub>	40	mA
* <sup>1</sup> Peak Forward Current	I <sub>FP</sub>	65	mA
Reverse Voltage	V <sub>R</sub>	4	V
Operating Temperature	T <sub>opr</sub>	-25~85	°C
Storage Temperature	T <sub>stg</sub>	-30~100	°C
* <sup>2</sup> Soldering Temperature	T <sub>sol</sub>	260°C for 5 seconds	

\*1.Duty ratio = 1/16, Pulse width = 0.1ms

\*2.Keep the distance more than 2.0mm from PCB to the bottom of LED package



- ※ Recommend document
  - . LED is very sensitive to ESD.

## Electrical Characteristics

Characteristic	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
Forward Voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> = 20mA	2.6	3.4	3.8	V
* <sup>4</sup> Luminous Intensity	I <sub>V</sub>	I <sub>F</sub> = 20mA	1760	3960	8910	mcd
Peak Wavelength	λ <sub>P</sub>	I <sub>F</sub> = 20mA	-	525	-	nm
Spectrum Bandwidth	Δ λ	I <sub>F</sub> = 20mA	-	30	-	nm
Reverse Current	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =4V	-	-	10	UA
* <sup>3</sup> Half Angle	θ <sub>1/2</sub>	I <sub>F</sub> = 20mA	-	±15	-	Deg

\*3. θ<sub>1/2</sub> is the off-axis angle where the luminous intensity is 1/2 the peak intensity

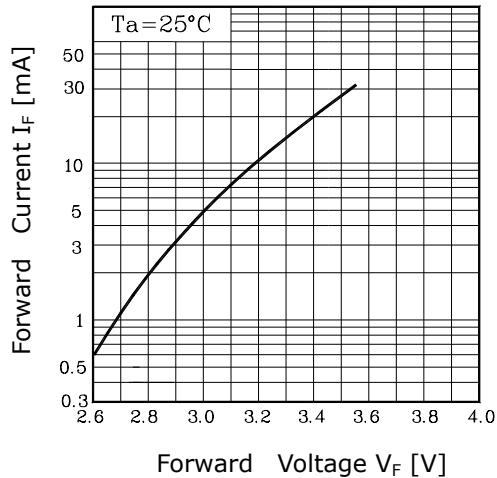
\*4. Luminous Intensity Maximum tolerance for each Grade Classification limit is ±18%

\*4. Luminous Intensity classification

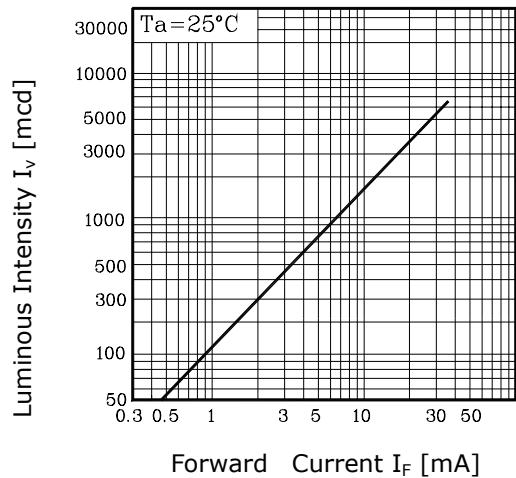
S	T	U	V
1760~2640	2640~3960	3960~5940	5940~8910

## Characteristic Diagrams

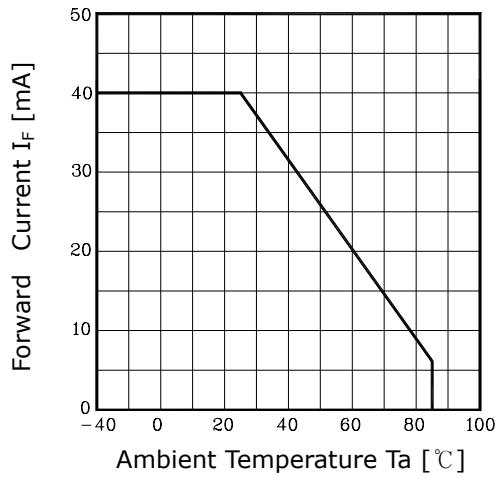
**Fig. 1**  $I_F - V_F$



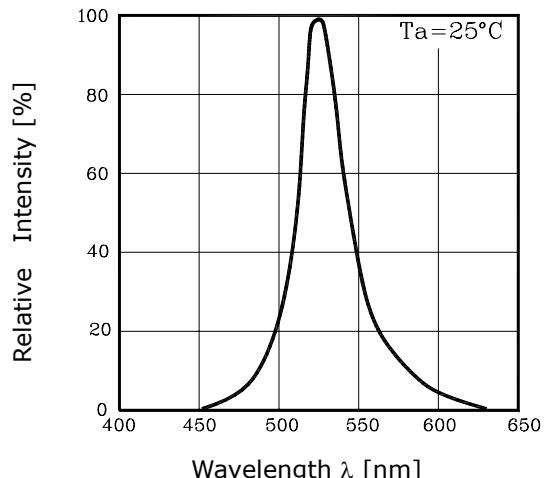
**Fig. 2**  $I_V - I_F$



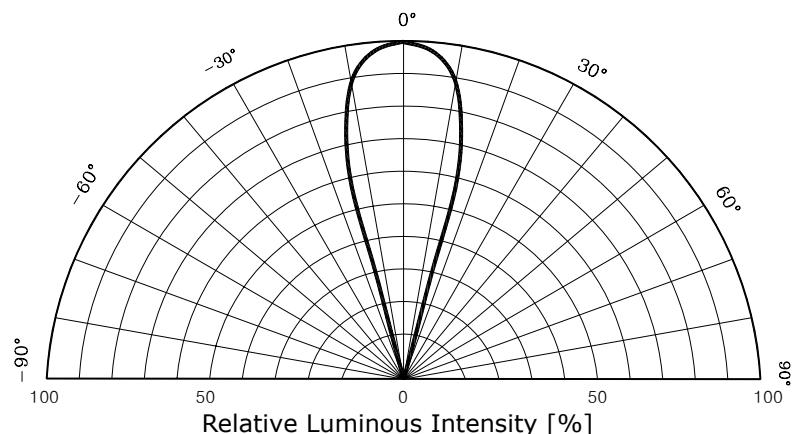
**Fig. 3**  $I_F - T_a$



**Fig.4 Spectrum Distribution**



**Fig. 5 Radiation Diagram**



## ■ 정전기 관련에 따른 제품 사용상 주의 사항

1. ESD(Electro Static Discharge) 주의 : Chip 재질은  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (Sapphire: 절연체) 재질로 되어 있어 정전기에 취약한 재질이며 Chip이 정전기에 의해 Damage가 가해지면 제 특성을 발휘하지 못하며 또한  $V_F$ 값이 현저히 Down 되면서 무 점등 현상 발생

### 2. ESD 발생 원리 및 대처 방법

2-1. ESD (Electro Static Discharge) 발생 원리 : 물질 구조의 분자설에 의하면 모든 물체는 (+)로 대전 된 원자핵과 그 주위를 도는 (-)로 대전 된 전자로 구성되어 중성의 상태를 유지하게 되지만 외부의 조건( 마찰, 압력, 온도, 습도 등)에 의하여 중성 상태의 물질이 (-)전하를 잃어 버리게 되면 (+)전하로 대전 되고 (+)양자를 잃게 되면 (-)로 대전하게 됨.

- \* 대전의 원인 : 접촉, 박리, 마찰, 충돌, 변형, 이온흡착 등
- \* 대전의 크기 결정 요인 : 접촉 면적, 압력, 마찰 빈도, 속도, 온도차등
- \* 대전의 극성 결정 요인 : 물질의 종류, 표면 상태, 이력 등

### 2-2. 대전 방지 및 제거 방법

#### ① 가습

- 가습에 의한 공기의 상대 습도를 높이면 물체 표면의 흡수량을 증가 시켜 표면 저항율을 저하시킴으로 물체는 대전성이 떨어진다.  
상대 습도는 80%가 적당하다.
- \* 습도에 따른 대전전위의 변화

대전물	상대습도 (10%~20%)	상대습도(65%~90%)
Table 작업을 행하는 경우	6[KV]	0.1[KV]
비닐 포장 자재	7[KV]	0.6[KV]
폴리백을 작업대에서 손으로 드는 경우	20[KV]	1.2[KV]

#### ② 대전 방지제 사용

- 대전 방지제는 절연물의 표면에 도포하거나 혼입하여 표면에 흡수성을 증가 시킴으로 표면 저항을 저하시켜 대전을 방지하는 방법으로 제품에의 영향을 고려

#### ③ 대전 방지용품 착용

- 인체를 접지 시켜 주거나 대전을 방지 시켜 주는 제품 : Wrist Strap (손목 띠), Heel Grounder, 대전 방지복, 제전화, 제전 장갑, 제전모 등
- Conveyer 또는 통로의 바닥이나 Table 등에 설치하여 대전을 안전하게 접지 시키는 제품 : Conductive Floor Mat

\* 현 제품 취급 시 주의 사항을 인지하시고 ESD에 주의하여 작업을 하시면 정전기로 인한 불량 발생율을 감소 시킬 수 있습니다.

**These AUK products are intended for usage in general electronic equipments(Office and communication equipment, measuring equipment, domestic electrification, etc.).**

**Please make sure that you consult with us before you use these AUK products in equipments which require high quality and/or reliability, and in equipments which could have major impact to the welfare of human life(atomic energy control, airplane, spaceship, traffic signal, combustion central, all types of safety device, etc.).**

**AUK cannot accept liability to any damage which may occur in case these AUK products were used in the mentioned equipments without prior consultation with AUK.**